第六章 存储器层次结构

- 教 师: 郑贵滨
- 听觉智能研究中心
- 哈尔滨工业大学,计算机科学与技术学院

主要内容

- 存储技术及其趋势
- ■局部性
- 存储器层次结构中的高速缓存

随机访问存储器(RAM)

■ 关键特征

- RAM封装在芯片上
- 基本存储单位是一个单元(cell), 每单元存储 1 比特
- 多个RAM芯片一起组成一个存储器

■ RAM 分为两类:

- SRAM (静态RAM)
- DRAM (动态 RAM)

SRAM vs DRAM一览

| | 每位晶 体管数 | 相对访 问时间 | 需要刷新? | 需要差错检测 电路(EDC)? | 相对 花费 | 应用 |
|------|------------|------------|-------|--------------------|----------|-------------|
| SRAM | 4或6 | 1X | 否 | 可能 | 100x | 高速缓存 存储器 |
| DRAM | 1 | 10X | 是 | 是 | 1X | 主存、帧 缓冲区 |

增强的DRAMs

- DRAM自1966年问世以来, 其基本单元就没有变化。
 - Intel 于1970年将其推向市场
- DRAM 集成了更好接口逻辑、更快的I/O传输接口:
 - 同步 DRAM (SDRAM)
 - 使用与内存控制器相同的时钟信号,取代异步控制信号
 - 允许行地址复用(比如, RAS, CAS, CAS, CAS)

增强的DRAMs

- DRAM 集成了更好接口逻辑、更快的I/O传输接口 (...)
 - 双倍数据速率同步DRAM (Double Data-Rate SDRAM, DDR SDRAM)
 - 每个时钟周期每个引脚使用两个时钟沿传送两比特控制信号
 - 以预取缓冲区的大小来划分不同类型:
 DDR (2 bits), DDR2 (4 bits), DDR3 (8 bits)
 - 到2010年,多数服务器和桌面系统均支持该标准
 - Intel Core i7 支持DDR3 和 DDR4 SDRAM

非易失性存储器

- DRAM 和 SRAM 是易失性存储器
 - 断电数据丢失
- 非易失性存储器断电后, 依然保持数据
 - 只读存储器(ROM): 生产时写入程序,只能写一次
 - 可编程 ROM (PROM): 可以重新编程一次
 - 可擦除 PROM (EPROM): 可用紫外线整块擦除
 - 电可擦除PROM (EEPROM): 可用电子信号整块擦除
 - 闪存: 基于EEPROM, 以块为单位进行擦除
 - 100,000 次擦除后即磨损坏

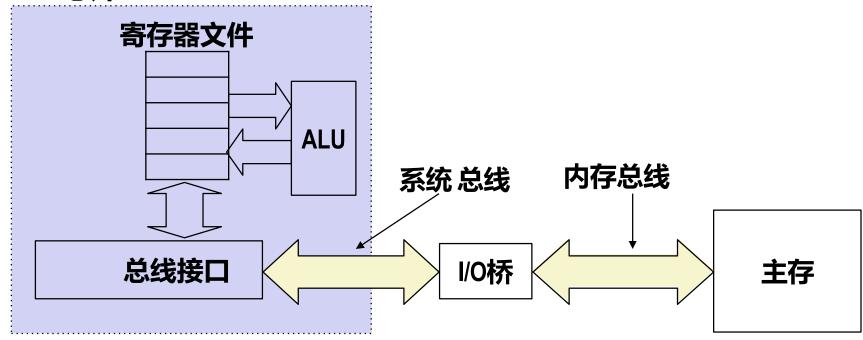
非易失性存储器

- 非易失性存储器的应用
 - 存储固件程序的ROM(BIOS,磁盘控制器, 网卡,图形加速器, 安全子系统,...)
 - 固态硬盘(U盘, 智能手机, mp3播放器, 平板电脑, 笔记本电脑...)
 - 磁盘高速缓存

连接CPU和存储器的典型总线结构

- 一条总线(bus)是由多条并排的电线组成的一束线, 其传输地址、数据和控制信号
- 多个设备共享多条总线

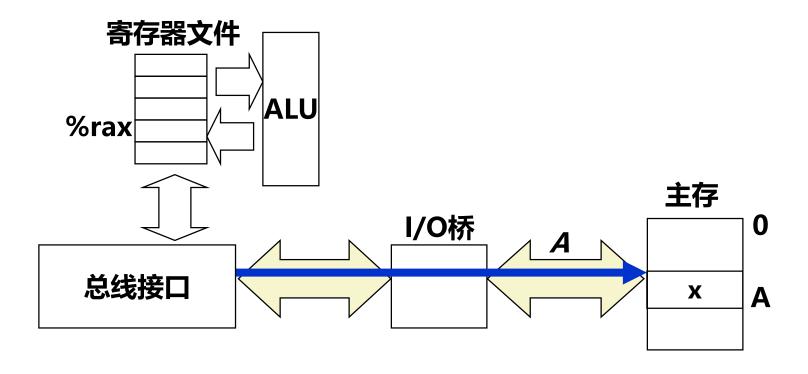




存储器读事务(1)

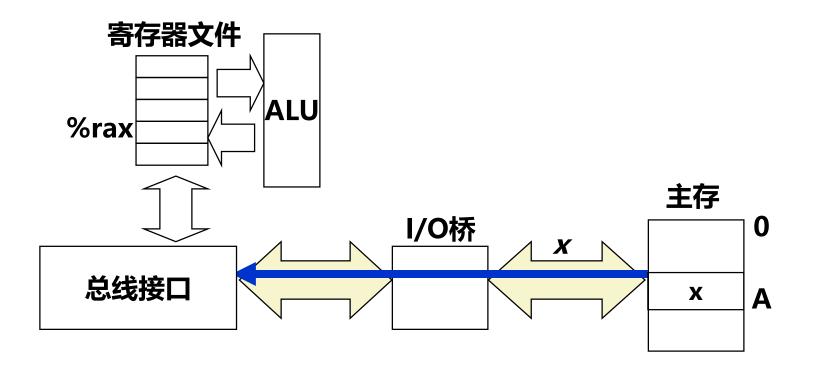
加载操作: movq A, %rax

■ CPU将地址A放到总线上



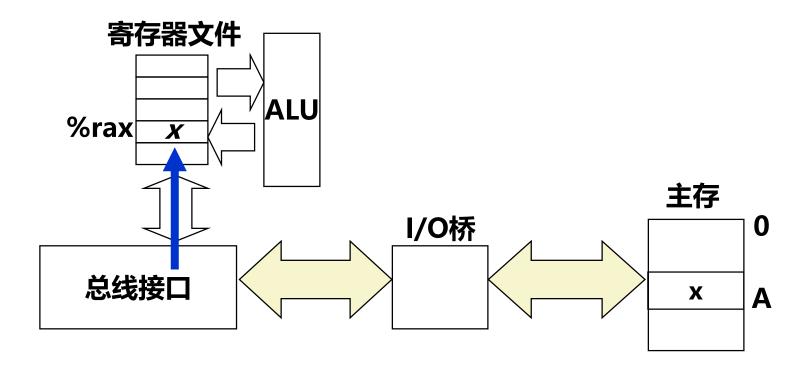
存储器读事务(2) 加载操作: movq A, %rax

■ 主存储器从总线上读地址A, 取出字x, 然后将x放到 总线上



存储器读事务(3) 加载操作: movq A, %rax

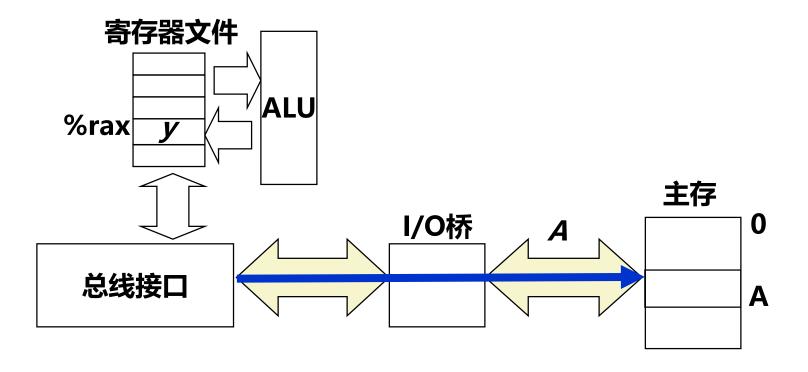
■ CPU 从总线上读入字x,并将其放入寄存器%rax



存储器写事务(1)

■ CPU 将地址A放到总线上,主存储器读地址A并等 待数据到来

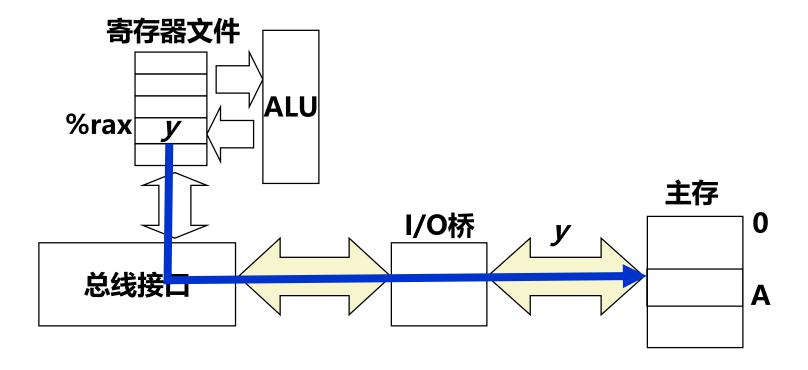
存储操作: movq %rax, A



存储器写事务(2)

■ CPU 将字y放到总线上

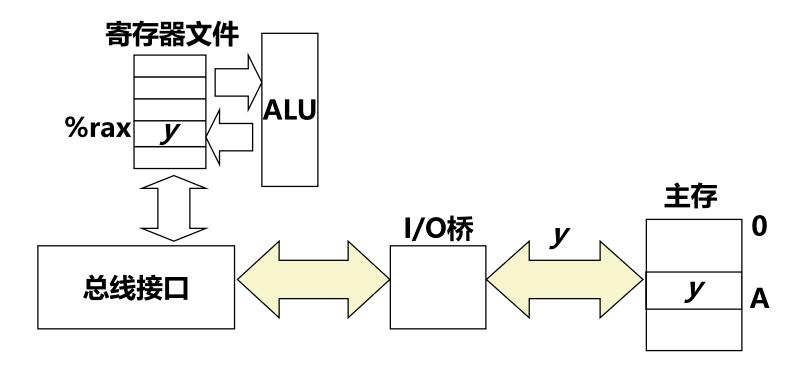
存储操作: movq %rax, A



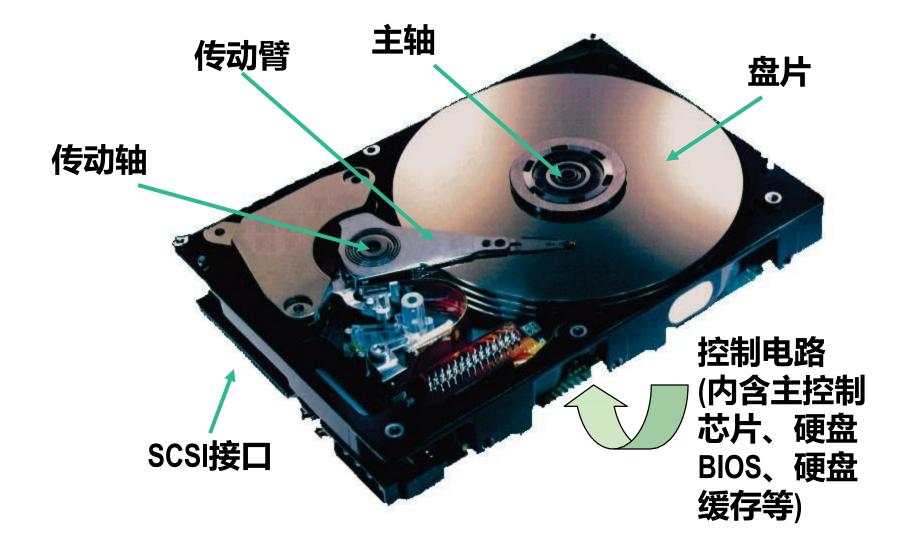
存储器写事务(3)

■ CPU 将字y放到总线上

存储操作: movq %rax, A

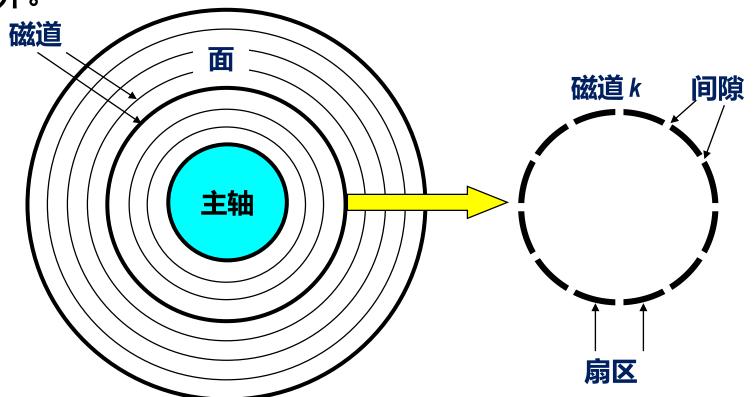


磁盘内部结构



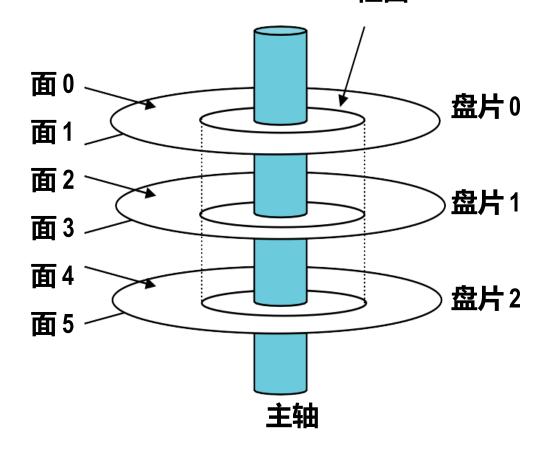
磁盘结构

- 磁盘由盘片(platter)构成,每个盘片包含两面(surface)。
- 每面由一组称为磁道(track)的同心圆组成。
- 每个磁道划分为一组扇区(sector),扇区之间由间隙(gap)隔开。



磁盘结构(多个盘片)

■ 同一半径上的所有磁道组成一个柱面。 柱面 k

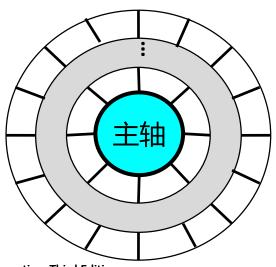


磁盘容量

- 容量(Capacity): 磁盘上可以存储的最大位(bits)数。
 - 制造商以千兆字节(GB)为单位来表达磁盘容量
 - 1 GB = 10°字节。
- 磁盘容量由以下技术因素决定:
 - 记录密度(Recording density) (位/英寸): 磁道一英寸的段中可放入的位数。
 - 磁道密度(Track density) (道/英寸): 从盘片中心出发半径上一英寸的段内可以有的磁道数。
 - <mark>面密度(Areal density)</mark> (位/平方英寸): 记录密度与磁道密度 的乘积。

分区记录

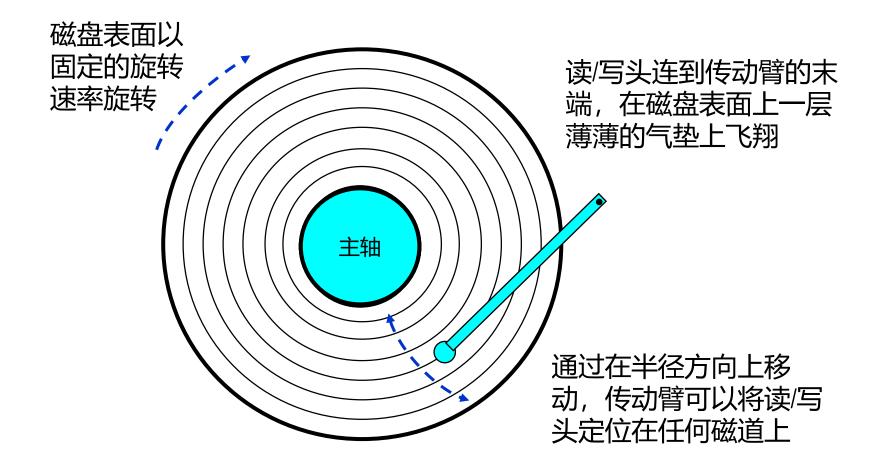
- 现代磁盘将所有磁道划分为若干分组(recording zone),组内 各磁道相邻
 - 区域内各磁道的扇区数目相同,扇区数取决于区域内最内侧磁道的圆周长
 - 各区域的每磁道扇区数都不同,外圈区域的每磁道扇区数 比内圈区域多
 - 所以我们使用每磁道平均扇区数来计算磁盘容量。



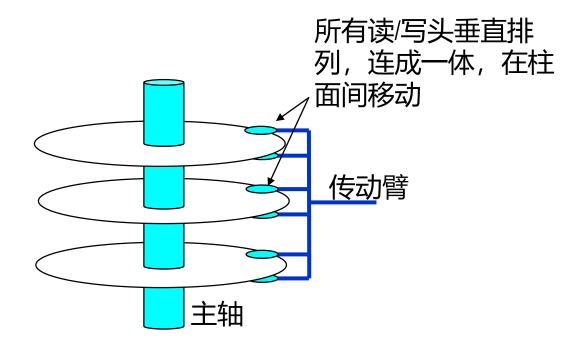
计算磁盘容量

- 容量 = (字节数/扇区)×(平均扇区数/磁道)×(磁道 数/面)×(面数/盘片)×(盘片数/磁盘)
- 例:
 - 512 字节/扇区
 - 300 扇区/磁道 (平均值)
 - 20,000 磁道/面
 - 2 面/盘片
 - 5 盘片/磁道
- 容量 = 512 × 300 × 20,000 × 2 × 5 = 30,720,000,000 = 30.72 GB

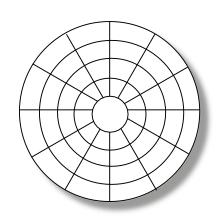
磁盘操作(单盘片视图)



磁盘操作(多盘片)



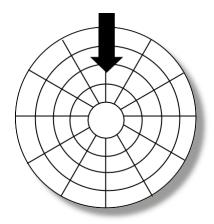
磁盘结构 - 单盘片俯视图



面由若干磁道构成

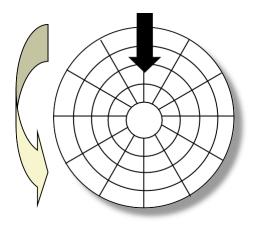
磁道被划分为若干扇区

磁盘访问



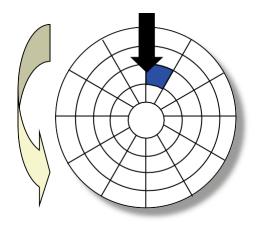
读/写头在磁道上方

磁盘访问



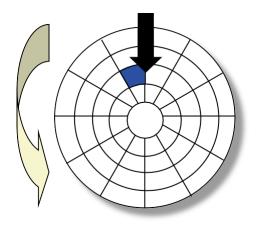
盘面逆时针旋转

磁盘访问-读



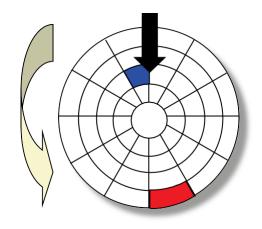
读取蓝色扇区

磁盘访问-读



读完蓝色扇区

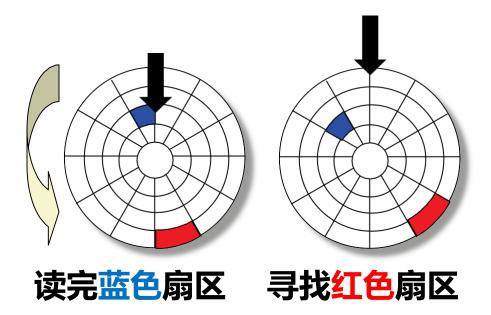
磁盘访问 - 读



读完蓝色扇区

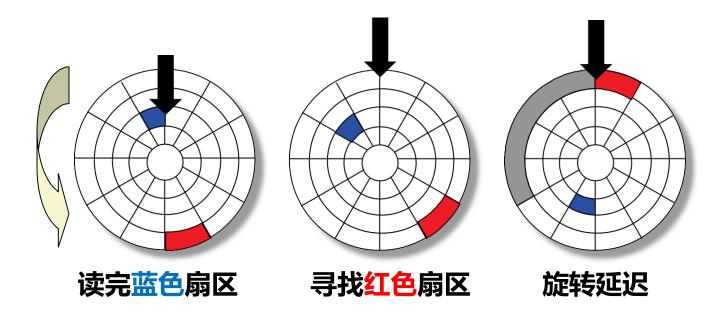
请求读取红色扇区

磁盘访问 - 寻道



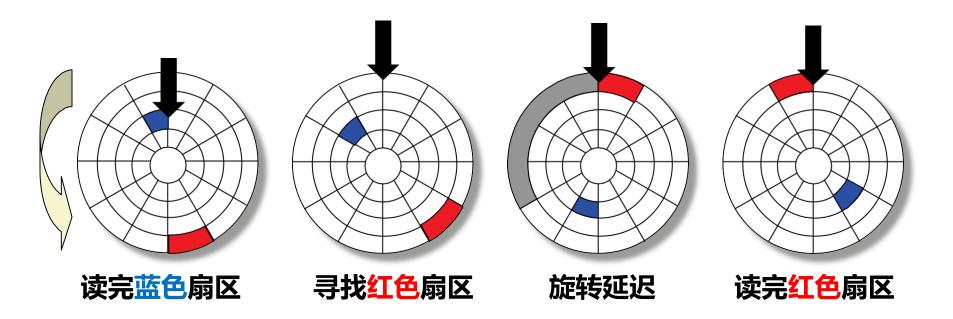
寻找红色扇区所在磁道

磁盘访问-旋转延迟



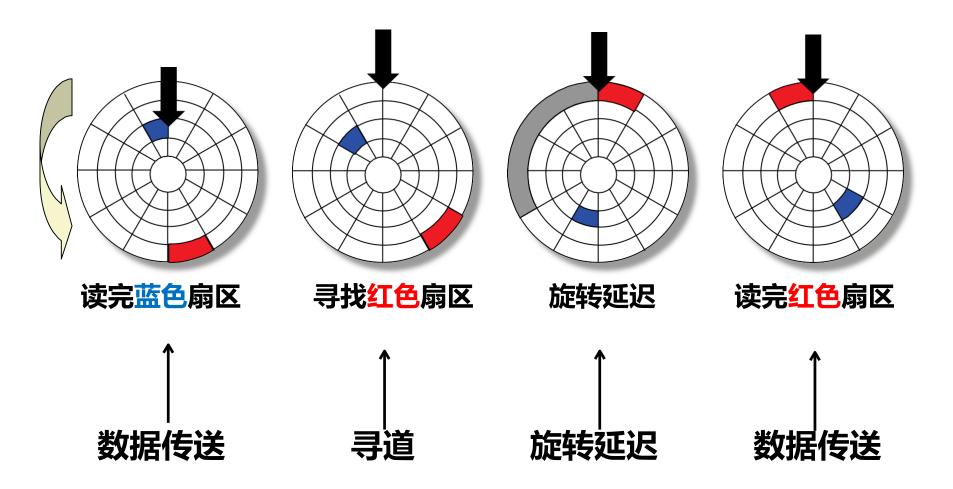
旋转盘面, 使读/写头在红色扇区上方

磁盘访问-读



读取红色扇区

磁盘访问-访问时间构成



磁盘访问时间

- 访问目标扇区的平均时间大致为
 - 访问时间 = 寻道时间 + 平均旋转延迟 + 数据传输时间
- 寻道时间(Seek time)
 - 读/写头移动到目标柱面所用时间
 - 通常寻道时间为: 3—9 ms
- 旋转延迟(Rotational latency)
 - 旋转盘面使读/写头到达目标扇区上方所用时间
 - 平均旋转延迟= 1/2 × 1/RPMs × 60 sec/1 min (RPM: 转/分钟)
 - 通常 RPMs = 7,200
- 数据传输时间(Transfer time)
 - 读目标扇区所用时间
 - 数据传输时间 = 1/RPM × 1/(平均扇区数/磁道)

 \times 60 secs/1 min

磁盘访问时间 - 举例

■ 给定条件:

- 旋转频率 = 7,200 转/分钟
- 平均寻道时间 = 9 ms
- 平均扇区数/磁道 = 400

■ 计算:

- 平均旋转延迟=?
- 数据传输时间=?
- 访问时间=?

■ 访问目标扇区的平均时间大 致为

- 访问时间 = 寻道时间 + 平均旋 转延迟 + 数据传输时间
- 寻道时间(Seek time)
 - 读/写头移动到目标柱面所用时间
 - 通常寻道时间为: 3—9 ms
- 旋转延迟(Rotational latency)
 - 旋转盘面使读/写头到达目标扇 区上方所用时间
 - 平均旋转延迟= 1/2 × 1/RPMs × 60 sec/1 min (RPM: 转/分 钟)
 - 通常 RPMs = 7,200 RPMs
- 数据传输时间(Transfer time)
 - 读目标扇区所用时间
 - 数据传输时间 = 1/RPM × 1/(平 均扇区数/磁道) × 60 secs/1 min

磁盘访问时间 - 举例

■ 给定条件:

- 旋转频率 = 7,200 转/分钟
- 平均寻道时间 = 9 ms
- 平均扇区数/磁道 = 400.

■ 计算结果:

- 平均旋转延迟 = 1/2×(60 secs/7200 RPM) × 1000 ms/sec = 4 ms
- 数据传输时间 = 60/7200 RPM × 1/400 扇区数/磁道 × 1000 ms/sec = 0.02 ms
- 访问时间 = 9 ms + 4 ms + 0.02 ms

■ 重 点:

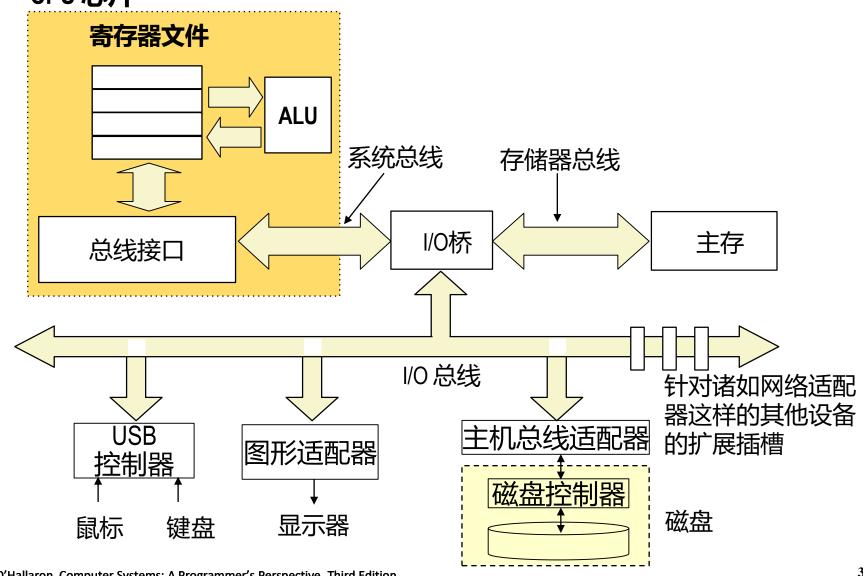
- 访问时间主要由寻道时间和旋转延迟时间组成。
- 访问扇区首位花费时间较长,其他位较快。
- SRAM 访问时间大约为4 ns/双字,DRAM 大约为 60 ns/双字。
 - 磁盘比SRAM慢大约40,000倍, 比DRAM慢大约2,500倍。

逻辑磁盘块

- 现代磁盘以简单的抽象视图来表示复杂的磁盘构造:
 - 磁盘被抽象成b个扇区大小的逻辑块(logical block)序列 (编号为0, 1, 2, ...)
- 逻辑块与物理扇区之间的映射关系
 - 由磁盘控制器维护
 - 磁盘控制器将逻辑块号转换为一个三元组(盘面,磁道,扇区)
- 允许磁盘控制器为每个分区预留一组柱面作为备份
 - 区分"格式化容量"与"最大容量"

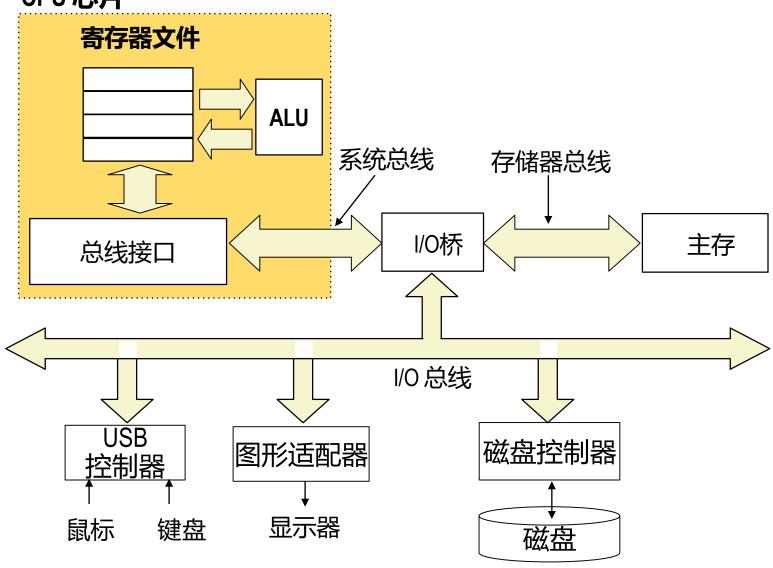
I/O 总线

CPU 芯片

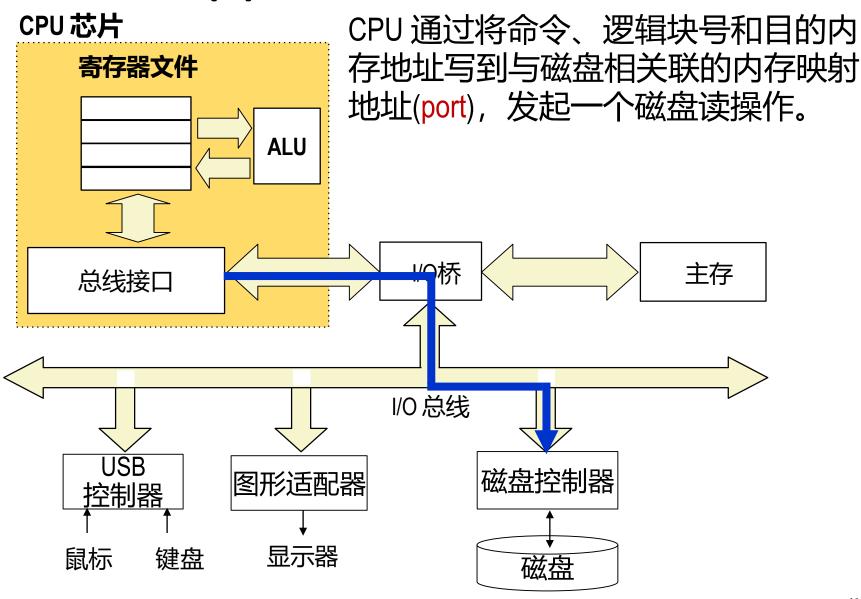


I/O 总线

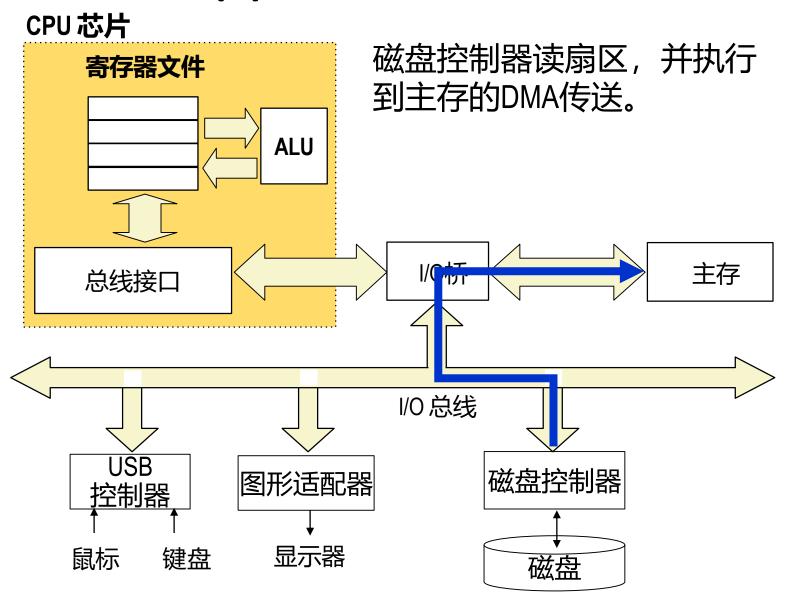
CPU 芯片

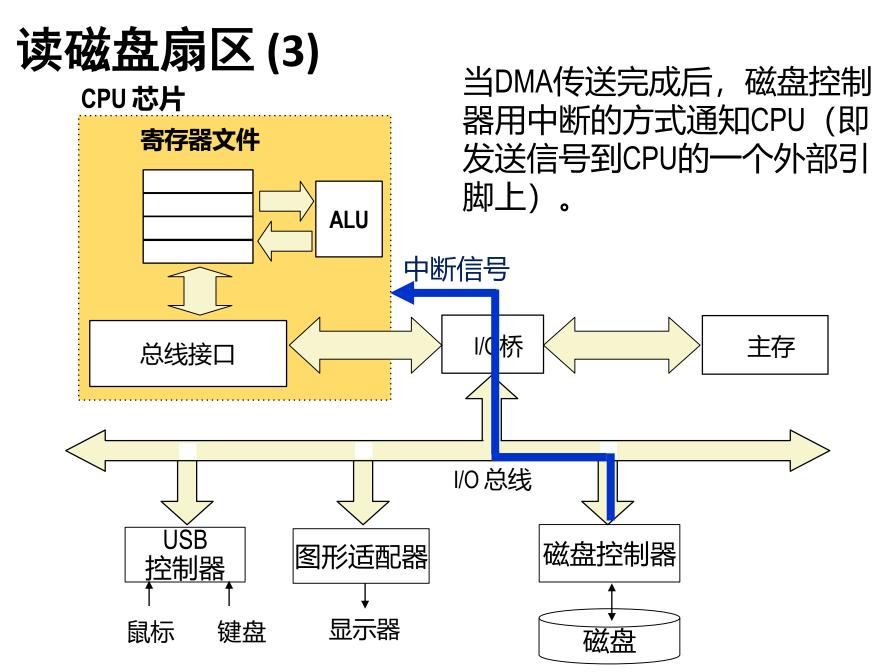


读磁盘扇区(1)

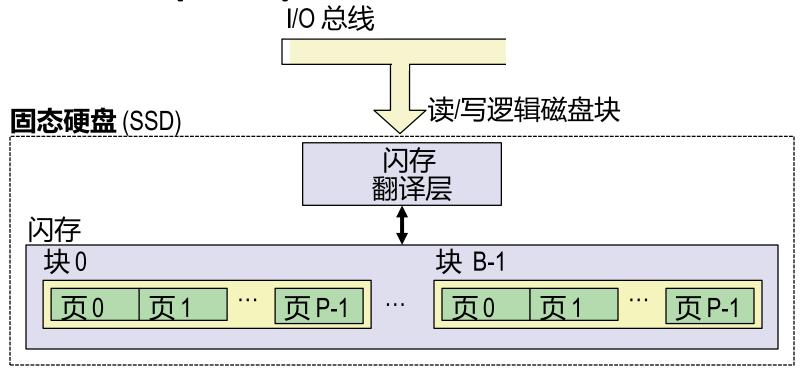


读磁盘扇区(1)





固态硬盘 (SSDs)



- 页大小: 512B~4KB, 块大小: 32~128页
- 数据以页为单位进行读写
- 只有某页所属块整个被擦除后,才能写该页
- 大约 100,000 次重复写之后, 块就会磨损坏

SSD 性能特性

顺序读吞吐量550 MB/s顺序写吞吐量470 MB/s随机读吞吐量365 MB/s随机写吞吐量303 MB/s平均顺序读访问时间50 us平均顺序写访问时间60 us

■ 顺序访问比随机访问快

■ 典型存储器层次结构问题

■ 随机写较慢

- 擦除块需要较长的时间(~1ms)
- 修改一页需要将块中所有页复制到新的块中
- 早期SSD 读/写速度之间的差距更大

资料来源: Intel SSD 730 产品详细说明书

SSD vs 机械磁盘

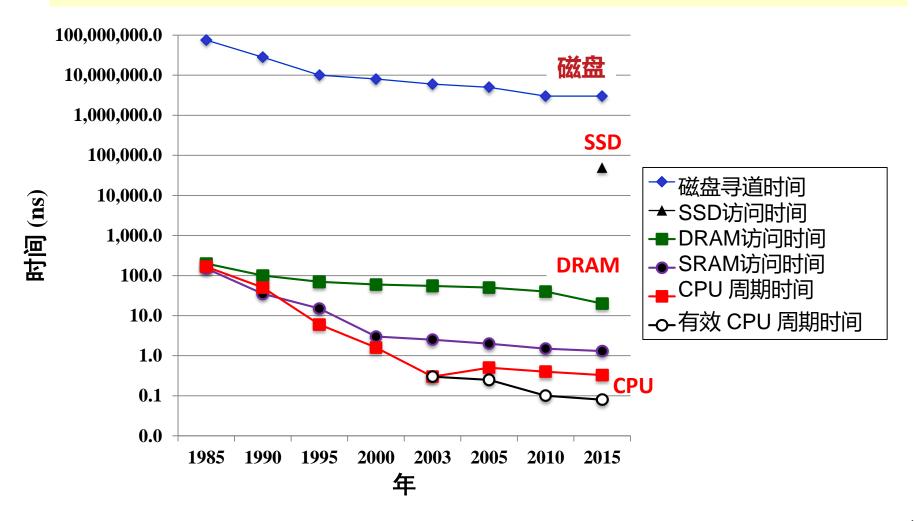
- 优点
 - 没有移动部件 → 更快、能耗更低、更结实(抗震)
- 缺点
 - 会磨损

通过flash翻译层中的"磨损均衡逻辑"缓解: 将擦除平均分布在所有块上来最大化每个块的寿命 Intel SSD 730 保证能经得起 128 PB (128 x 10¹⁵ 字节) 的写

- 2015年, SSD每字节比机械磁盘贵大约30倍,目前约10倍
- 应用
 - MP3播放器、智能手机、笔记本电脑
 - 开始在台式机和服务器中应用

CPU-储存器的速度差距

DRAM、磁盘和CPU之间的速度差距在变大.....



主要内容

- 存储技术与趋势
- ■局部性
- 存储器层次结构中的高速缓存

用局部性原理(locality)来解决

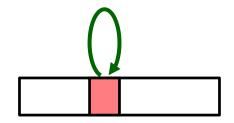
■ 解决CPU-存储器之间速度差距的关键是程序中特有的局部性特点。

局部性

■ 局部性原理(Principle of Locality)

程序倾向于使用距离最近用过的指令/数据地址相近或相等的指令/数据。

- 时间局部性(Temporal locality)
 - 最近访问过的信息,很可能在近期还会 被再次访问



■ 空间局部性(Spatial locality)

地址接近的数据项,被使用的时间也倾向于 接近



局部性举例

```
sum = 0;
for (i = 0; i < n; i++)
    sum += a[i];
return sum;</pre>
```

■ 对数据的引用

- 顺序访问数组元素 (步长为1的引用模式)
- 变量sum在每次循环迭代中被引用一次

空间局部性时间局部性

■ 对指令的引用

- 顺序读取指令
- 重复循环执行for循环体

空间局部性时间局部性

对局部性的定性评价

- 通过查看程序代码,能对程序局部性有定性的认识
 - 专业程序员的一项关键技能。
- 问题: 针对数组 a, 函数sum_array_rows具有良好的局部性吗?

```
int sum_array_rows(int a[M][N])
{
  int i, j, sum = 0;

  for (i = 0; i < M; i++)
     for (j = 0; j < N; j++)
        sum += a[i][j];
  return sum;
}</pre>
```

局部性举例

■问题:针对数组 a, 函数sum_array_rows具有良好的局部性吗?

```
int sum_array_cols(int a[M][N])
{
    int i, j, sum = 0;

    for (j = 0; j < N; j++)
        for (i = 0; i < M; i++)
            sum += a[i][j];
    return sum;
}</pre>
```

局部性举例

■ 问题: 改变下面函数中循环的顺序,使它以步长为 1 的引用模式扫描三维数组 a ,从而函数具有良好的局部性

存储器层次结构

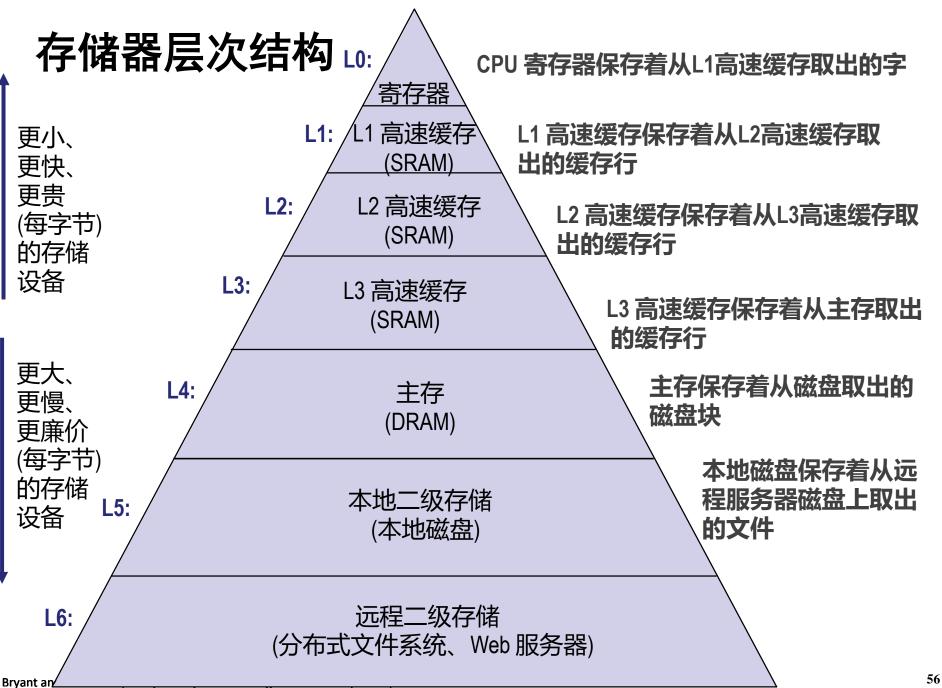
- 软硬件的基本特性:
 - 高速存储器: 成本高、容量小、耗电大易发热
 - CPU与存储器之间的速度差距越来越大
 - 程序编写的好,往往表现出良好的局部性

■ 这些基本特性相互补充

■ 基于以上特性,构造好的存储器系统—存储器层次 结构(memory hierarchy).

主要内容

- 存储技术及其趋势
- ■局部性
- 存储器层次结构、高速缓存

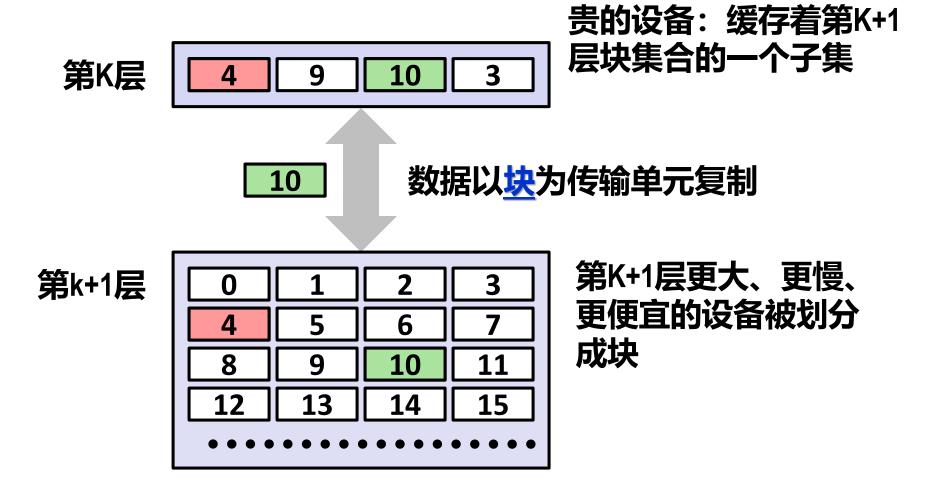


高速缓存

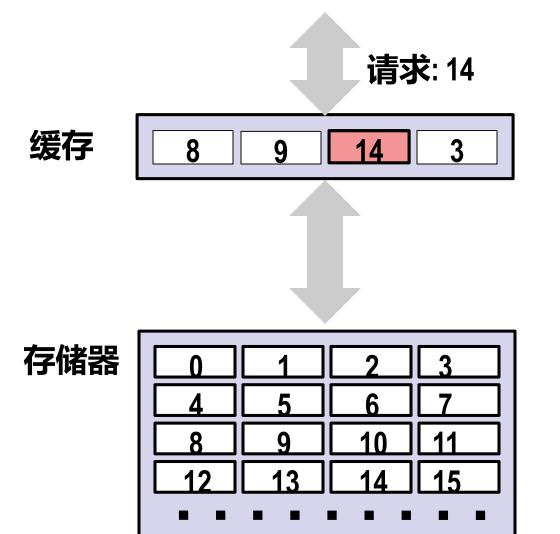
- 高速缓存(Cache): 将一种更小、速度更快的存储设备,作为更大、更慢存储设备的缓存区。
- 存储器层次结构的基本思想
 - 位于k层的更快更小存储设备作为位于k+1层的更大更慢存储设备的缓存。
- 存储器层次结构为何行的通?
 - 因为局部性原理,程序访问第k层的数据比访问第 k+1层的数据要频繁
 - 第k+1层的存储设备更慢、容量更大、价格更便宜
- 妙策: 存储器层次结构,构建了一个大容量的存储池,像 底层存储器一样廉价,而又可以达到顶层存储器的速度。

第K层更小、更快、更昂

高速缓存的基本概念



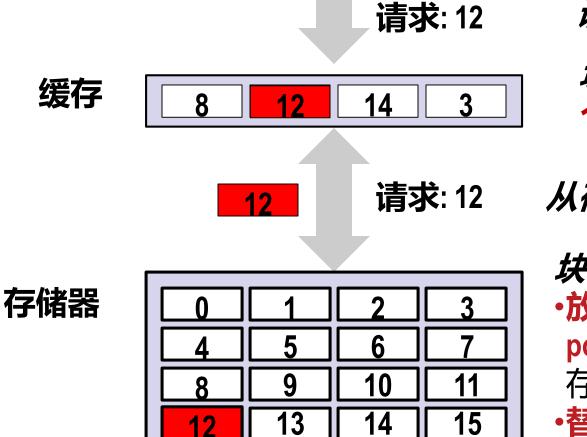
高速缓存的基本概念: 命中



请求块 b 中的数据

块b 在缓存中: 命中!

高速缓存的基本概念: 不命中



请求块 b 中的数据

块 b 不在缓存中: 不命中!

从存储器中取出块 b

块b存储在缓存中

- •放置策略(Placement policy): 决定块b放在缓存中的位置
- •替换策略(Replacement policy): 决定该替换存储器中的哪一块

高速缓存基本概念:缓存不命中的种类

- 冷不命中(或强制性不命中)
 - 当缓存为空时,对任何数据的请求都会不命中

■ 冲突不命中

- 大部分缓存将第k+1层的某个块限制在第k层块的一个 子集里(有时只是一个块)
 - 例如, 第k+1层的块i必须放置在第k层的块 (i mod 4) 中
- 当缓存足够大,但是被引用的对象都映射到同一缓存块中, 此种不命中称为冲突不命中

例:程序请求块 0, 8, 0, 8, 0, 8, 每次请求都不命中

■ 容量不命中

■ 当工作集(working set)的大小超过缓存的大小时,会发生容量不命中

存储器层次结构中的缓存

| 缓存类型 | 缓存什么 | 存在何处 | 延迟(周期数) | 谁管理 |
|-------------|---------|-------------|---------------|--------------|
| 寄存器 | 4-8 字节字 | CPU 核心 | 0 | 编译器 |
| TLB | 地址译码 | 片上 TLB | 0 | 硬件MMU |
| L1 高速缓存 | 64字节块 | 片上 L1 | 4 | 硬件 |
| L2 高速缓存 | 64字节块 | 片上 L2 | 10 | 硬件 |
| 虚拟内存 | 4KB 页 | 主存 | 100 | 硬件 + OS |
| 缓冲区缓存 | 部分文件 | 主存 | 100 | OS |
| 磁盘缓存 | 磁盘扇区 | 磁盘控制器 | 100,000 | 磁盘固件 |
| 网络缓冲 区缓存 | 部分文件 | 本地磁盘 | 10,000,000 | NFS 客户 |
| 浏览器缓存 | Web页 | 本地磁盘 | 10,000,000 | Web浏览器 |
| Web缓存 | Web 页 | 远程服务器 磁盘 | 1,000,000,000 | Web代理 服务器 |

总结

■ CPU、主存、大容量存储设备之间的速度差距持续 扩大

■ 编写良好的程序表现出良好的局部性

■ 利用局部性特点,基于高速缓存的存储器层次结 构有利于缩小速度差距

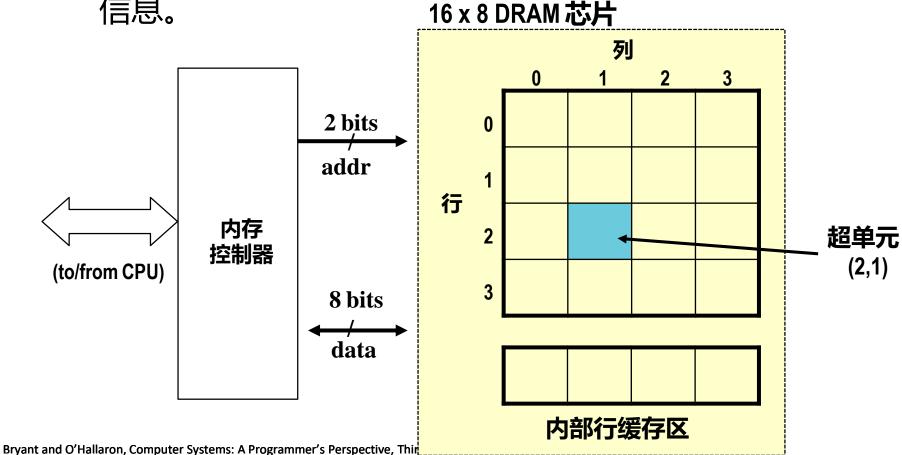
补充: DRAM内存组织结构 读/写操作

传统 DRAM 组织结构

d×w DRAM:

■ DRAM芯片中的单元被分成 d 个超单元,每个超单元都 由w个DRAM单元组成。一个d×w 的DRAM总共存储dw位

信息。

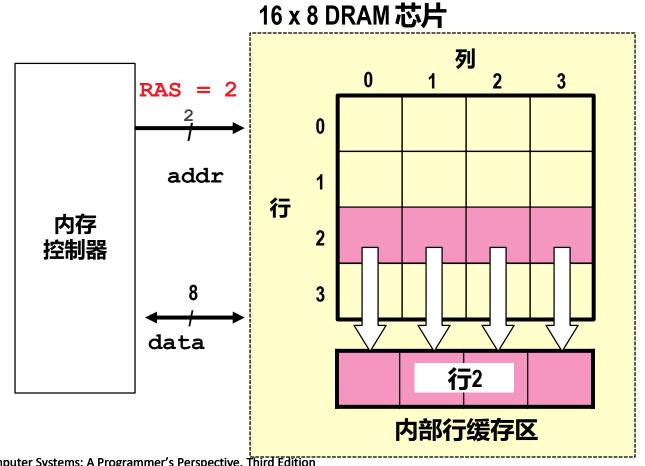


65

读 DRAM 超单元 (2,1)

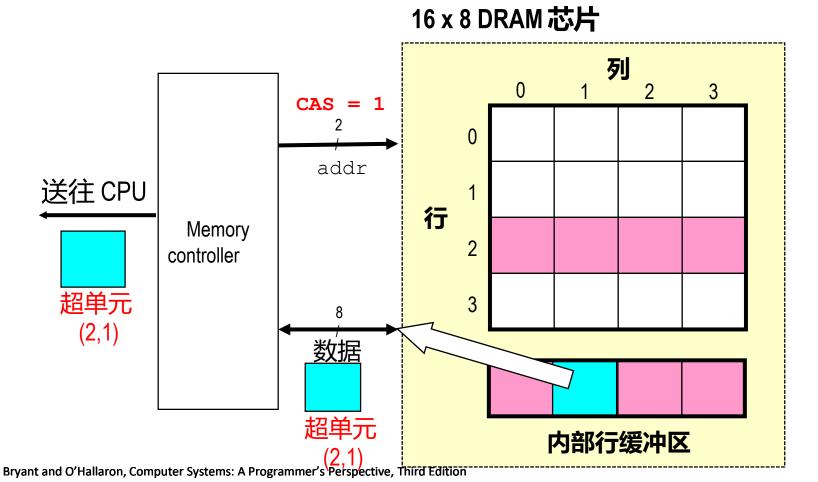
Step 1(a): 行访问选通脉冲(RAS) 选中行 2。

Step 1(b): 行 2 的整个内容复制到内部行缓存区。



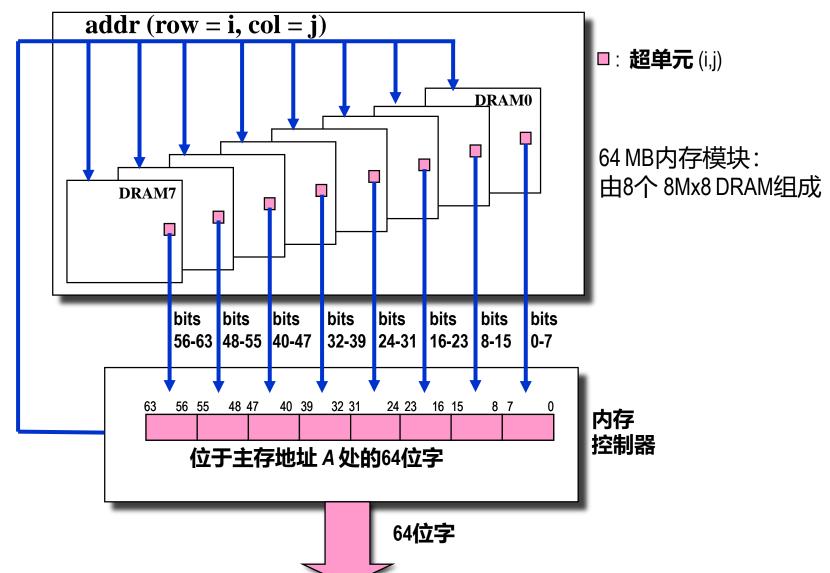
读 DRAM 超单元 (2,1)

- Step 2(a): 列访问选通脉冲 (CAS) 选中列 1。
- Step 2(b): 超单元 (2,1) 从内部行缓存区复制到data线上,最终发送给 CPU。



内存模块

Bryant and O'Hallaron, Computer Systems: A Programmer's Perspective, Third Editor



存储技术趋势

SRAM

| 度量标准 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2015:1985 |
|------------------|-------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 美元/MB | 2,900 | 320 | 256 | 100 | 75 | 60 | 25 | 116 |
| 访问时间 (ns) | 150 | 35 | 15 | 3 | 2 | 1.5 | 1.3 | 115 |

DRAM

| 度量标准 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2015:1985 |
|------------|-------|------|------|------|-------|-------|--------|-----------|
| 美元/MB | 880 | 100 | 30 | 1 | 0.1 | 0.06 | 0.02 | 44,000 |
| 访问时间 (ns) | 200 | 100 | 70 | 60 | 50 | 40 | 20 | 10 |
| 典型的大小 (MB) | 0.256 | 4 | 16 | 64 | 2,000 | 8,000 | 16.000 | 62,500 |

磁盘

| 度量标准 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2015:198 | 5 |
|--|-----------|-------|------|------|------|-------|-------|-----------|---|
| 美元/GB | 100,000 | 8,000 | 300 | 10 | 5 | 0.3 | 0.03 | 3,333,333 | |
| 访问时间 (ms) | 75 | 28 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 25 | |
| 典型的大小 (GB) | 0.01 | 0.16 | 1 | 20 | 160 | 1,500 | 3,000 | 300,000 | |
| Bryant and O'Hallaron, Computer Systems: A Programmer's Perspective, Third Edition | | | | | | | | | |

CPU时钟频率

| | | | ĺ | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|---------|-------|--------|-----------|--------------|--|--|
| | 1985 | 1990 | 1995 | 2003 | 2005 | 2010 | 2015 | 2015:1985 | |
| CPU | 80286 | 80386 | Pentium | P-4 | Core 2 | Core i7(ı | n) Core i7(l | h) | |
| 时钟 频率(MH | lz) 6 | 20 | 150 | 3,300 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 500 | |
| 时钟 周期 (ns |) 166 | 50 | 6 | 0.30 | 0.50 | 0.4 | 0.33 | 500 | |
| 核数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| 有效 时钟 周期(ns) | 166 | 50 | 6 | 0.30 | 0.25 | 0.10 | 0.08 | 2,075 | |
| | | | | | | | ` ' | ehalem 处理器 aswell 处理器 | |